

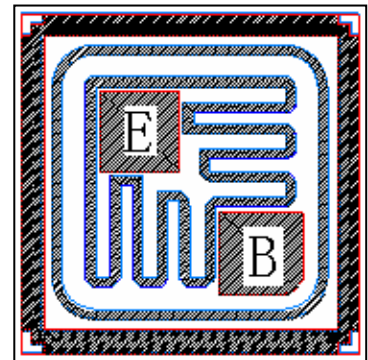


5551 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：C043BJ-01
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：430 × 430μm²
 焊位尺寸：B 极 107×107μm²，E 极 101×101μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2N5551，H5551

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....625mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压.....180V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....160V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....6V
 I_C——集电极电流.....600mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			0.05	μA	V _{CB} =120V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			0.05	μA	V _{EB} =4V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	80				V _{CE} =5V, I _C =1mA
		80		280		V _{CE} =5V, I _C =10mA
		30				V _{CE} =5V, I _C =50mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			0.15	V	I _C =10mA, I _B =1mA
				0.2	V	I _C =50mA, I _B =5mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1	V	I _C =10mA, I _B =1mA
				1	V	I _C =50mA, I _B =5mA
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	180			V	I _C =100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	160			V	I _C =1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	I _E =10μA, I _C =0
f _T	特征频率	100		300	MHz	V _{CE} =10V, I _C =10mA f=100MHz